

(11)Publication number:

06-333429

(43)Date of publication of application: 02.12.1994

(51)Int.CI.

H01B 3/12 C04B 35/20 H01P 7/10

(21)Application number: 05-142693

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

21.05.1993

(72)Inventor: TACHIKAWA TSUTOMU

TAMURA HIROSHI

## (54) DIELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION FOR HIGH FREQUENCY

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a dielectric porcelain composition for high frequency, which can be sintered at a low temperature and which has a high quality value and a low dielectric constant. CONSTITUTION: One or both of the material (Ba source), which is changed to the barium oxide by sintering, and the material (Sr source), which is changed to the strontium oxide, is added to the porcelain composition having the composition expressed with a general formula: xMgO-ySiO2 (x, y in the formula mean the weight percentage and satisfy  $40 \le x \le 85$ ,  $15 \le y \le 60$ , x+y=100) at 0.3-3.0 weight% of the total quantity of BaCO3 or SrCO3.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

31.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3446249

[Date of registration]

04.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-333429

(43)公開日 平成6年(1994)12月2日

(51) Int.Cl.5

設別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H01B 3/12

333

9059-5G

C 0 4 B 35/20

8924-4G

H01P 7/10

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-142693

(71)出願人 000006231

FΙ

株式会社村田製作所

(22)出顧日

平成5年(1993)5月21日

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

<del>क्ते</del>।। क्र

(72)発明者 立川 勉

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 田村 博

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 弁理士 西澤 均

## (54) 【発明の名称】 高周波用誘電体磁器組成物

## (57)【要約】

【目的】 低温で焼結することが可能で、かつ、高いQ値と低い誘電率を有する高周波用誘電体磁器組成物を得る。

【構成】 一般式:xMgO-ySiO、(但し、式中のx、yは、各成分の重量百分率を表し、 $40 \le x \le 85$ 、 $15 \le y \le 60$ 、x+y=100である)で表される組成を有する磁器組成物に、焼結することによりバリウム酸化物となる物質(Ba源)及び焼結することによりストロンチウム酸化物となる物質(Sr源)の一方または両方を、それぞれBaCO、またはSrCO、に換算して、その合量が $0.3\sim3.0$ 重量%になるような割合で添加する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式:xMgO-ySiOx(但し、 式中のx,yは、各成分の重量百分率を表し、40≦x  $\leq 85$ ,  $15 \leq y \leq 60$ , x + y = 100である) で表 される組成を有する磁器組成物に、焼結することにより バリウム酸化物となる物質(Ba源)及び焼結すること によりストロンチウム酸化物となる物質 (Ѕ г 源) の一 方または両方を、それぞれBaCO。またはSrCO。に 換算して、その合量が0.3~3.0重量%になるよう な割合で添加したことを特徴とする高周波用誘電体磁器 10 組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、誘電体磁器組成物に 関し、特に、マイクロ波集積回路などのマイクロ波帯で 用いられる回路素子用基板(磁器基板)、あるいは誘電 体共振器用支持台用の材料として有用な髙周波用誘電体 磁器組成物に関する。

[0002]

波回路素子には、誘電体共振器を、支持台を介して基板 (磁器基板) に固定する構造が採用される場合がある が、この場合、支持台には誘電率が低く、誘電損失(ta nδ)が小さい材料を使用する必要がある。そのため、 従来は、上記支持台用の材料として、例えば、フォルス テライトなどが使用されており、また、磁器基板用の材 料として、例えばアルミナ磁器などが使用されている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記フォルス テライトは、比誘電率 (ε,) が6.5程度と小さいも のの、低温で焼結することが困難であり、純粋なフォル ステライトは1500℃の高温焼成でも完全に焼結せ ず、工業的に大量生産するには適していないという問題 占がある。

【0004】そこで、従来は、低温での焼結を可能にす るために、低温焼成剤として粘土などを添加している が、これらの低温焼成剤の添加により、Q値が10GH 2で3000程度にまで低下するという問題点がある。 【0005】そのため、より高周波での用途が増大する につれて、さらにQ値の高い材料への要求が増大するに 至っている。

【0006】この発明は、上記問題点を解決するもので あり、低温で焼結することが可能で、かつ、高いQ値と 低い誘電率を有する高周波用誘電体磁器組成物を提供す ることを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、この発明の高周波用誘電体磁器組成物は、一般式: xMgO-ySiO』(但し、式中のx, yは、各成分 の重量百分率を表し、40≤x≤85,15≤y≤6 0, x+y=100である)で表される組成を有する磁 器組成物に、焼結することによりバリウム酸化物となる 物質(Ba源)及び焼結することによりストロンチウム 酸化物となる物質(Sェ源)の一方または両方を、それ ぞれBaCO,またはSrCO,に換算して、その合量が 0.3~3.0重量%になるような割合で添加したこと を特徴としている。

【0008】この発明の高周波用誘電体磁器組成物にお 【従来の技術】マイクロ波集積回路をはじめとする高周 20 いては、Ba源はBaCO,に換算して、また、Sェ源 はSrCO, に換算して、その合計量が0.3~3.0 重量%となるような割合で添加されるが、 Ba源及びS r源は、そのいずれか一方のみが添加されてもよく、ま た、その両方が添加されてもよい。

> 【0009】また、Ba源及びSr源としては、BaC O<sub>1</sub>, SrCO<sub>1</sub>などを代表的な例として挙げることがで きるが、焼結することによりバリウム酸化物(BaOな ど),ストロンチウム酸化物(SrOなど)になる種々 の物質のうちから、任意の物質を選択して用いることが 30 可能である。

[0010]

【実施例】以下、この発明の実施例を比較例とともに示 して、発明の特徴をさらに詳しく説明する。

【0011】まず、原料として、MgO, SiOz, B aCO,,及びSrCO,を用い、これらを、表1に示す 割合の組成が得られるように秤量、配合した。

[0012]

【表1】

	3				4	
试料番号	組 成 (重量%)			電気特性		
	MgO	SiOz	Bacos	SrCO:	€,	Q (10GHz)
1	85.0	15.0	0. 3	-	8. 0	6900
2	56.8	43.2	0.3	_	6. 3	6700
3	45.0	55.0	0.3	_	6, 2	6000
4	85.0	15.0	0.5	_	8; 0	6900
5	70.0	25.0	0.5		7, 2	6800
6	56.8	43. 2	0.5	-	6, 4	7300
7	45.0	55.0	0.5		6 3	6200
8*	90.0	10.0	1.0	_	8 6	5800
9	85.0	15.0	1.0		8, 0	6200
10	70.0	30.0	1.0	_	7, 2	6300
11	60.0	40.0	1.0	-	6.6	6200
12	56.8	43. 2	1.0	_	6. 4	7000
13	53.0	47.0	1.0	_	6.5	6800
14	45.0	55.0	1.0	-	6.3	6100
15*	40.0	80.0	1.0	_	6, 3	4300
16*	30.0	70.0	1.0	_	6, 1	3100
17	85.0	15.0	3.0	_	8.0	4200
18	70.0	30.0	3.0	_	7.3	4300
19	56.8	43. 2	3.0	-	6,5	4300
20	45.0	55.0	3.0		6.5	3400
21*	85.0	15. 0	5.0		8. 1	3900
22*	56.8	43. 2	5.0	_	6, 6	3100
23*	45.0	55. 0	5. 0		6, 4	2900
24	85.0	15. 0	-	1.0	8: 1	6700
25	56.8	43. 2	_	1. 0	6, 5	7200
26	45.0	55. 0	-	1.0	6. 4	6200
27	56.8	43. 2	0. 5	0. 5	6. 5	7000
28	56.8	43. 2	0. 3	0.7	6. 6	7100

\* 印はこの発明の範囲外の比較例であり、他はこの発明の範囲内の実施例である。

【0013】次に、この配合原料を16時間湿式混合し 40 Hzにおける誘電特性を誘電体共振器法により測定し た後、蒸発乾燥した。それから、この混合物を1100 ℃で2時間仮焼した後、粉砕した。

【0014】そして、得られた仮焼粉末に適量のバイン ダを添加して造粒し、これを2000kg/cm²の圧力の 下で成形して、直径22mm、厚さ11mmの成形体を得 た。

【0015】それから、この成形体を空気中1350~ 1400℃で4時間焼結して、誘電体磁器(試料)を得

【0016】このようにして得た試料について、10G 50 い。すなわち、この発明の実施例にかかる誘電体磁器

た。その結果を表1に示す。

【0017】なお、表1において、試料番号に\*印を付 したものは、この発明の範囲外の比較例であり、その他 のものは、この発明の範囲内の実施例である。

【0018】この発明の範囲内の誘電体磁器組成物は、 上述のように、1350~1400℃の低温で焼結する ことが可能であり、得られた焼結体 (誘電体磁器) は、 表1に示すように、比誘電率  $(\epsilon_r)$  が約6~8と低 く、Q値は10GHzにおいて5000~7000と高

は、低温で焼結したにもかかわらず、比誘電率 $\epsilon$ ,及び 高周波領域(10GHz)におけるQ値について良好な 結果が得られていることがわかる。

【0019】次に、この発明の高周波用誘電体磁器組成 物において、その組成範囲を限定した理由について説明

【0020】 [MgO, SiO,の割合] 主成分である Mg Oの含有率(重量百分率)が40%(すなわち、一 般式:xMgO-ySiO,におけるxの値が40)未 満の場合には良好な焼結体を得ることができず、しかも 10 Q値が低下する。また、MgOの含有率が85%(すな わち、xの値が85)を越えると比誘電率が高くなりす ぎる傾向がある。したがって、MgOの含有率は40~ 85% (x=40~85) の範囲にあることが好まし い。また、xMgO-ySiO,の残部を構成するSi O,の含有率は15~60%(すなわち、Y=15~6 0)の範囲に有ることが好ましい。

【0021】[Ba源(BaCO<sub>3</sub>), Sr源(SrC O,) の割合] BaCO,などのBa源、及びSrCO, Sェ源の一方または両方を、それぞれBaCO。または SrC〇, に換算して、その合量が0.3重量%未満に なるような割合で添加した場合には低温(1350~1 400℃)で焼結させることが困難になり、また、その 合量が3.0重量%を越えるような割合で添加した場合 にはQ値が低下する。したがって、Ba源及びSr源の 添加量は、それぞれをBaCO,及びSrCO,に換算し 場合の合量が0.3~3.0重量%の範囲になるような

割合であることが好ましい。

[0022] 【発明の効果】上述のように、この発明の髙周波用誘電 体磁器組成物は、一般式: xMgO-ySiOz(但 し、式中のx, yは、各成分の重量百分率を表し、40  $\le x \le 85$ ,  $15 \le y \le 60$ , x + y = 100 cb3) で表される組成を有する磁器組成物に、焼結することに よりバリウム酸化物となる物質(Ba源)及び焼結する ことによりストロンチウム酸化物となる物質(Sr源) の一方または両方を、それぞれBaCO。またはSrC 〇, に換算して、その合量が0.3~3.0重量%にな るような割合で添加するようにしているので、これらの 添加物により、Q値を向上させるとともに、焼結性を改 善することが可能になる。

【0023】すなわち、この発明の高周波用誘電体磁器 組成物を用いることにより、マイクロ波領域などの髙周 などのSr源の添加量については、例えば、Ba源及び 20 波帯域において高いQ値を有するとともに、フォルステ ライトやステアタイトに匹敵する低誘電率を有する髙周 波用誘電体磁器を得るととが可能になる。しかも、低温 で焼結することが可能であるため、低コストで、工業的 に大量生産することが可能になる。